

NPNエピタキシャル形シリコン・トランジスタ  
低周波増幅用

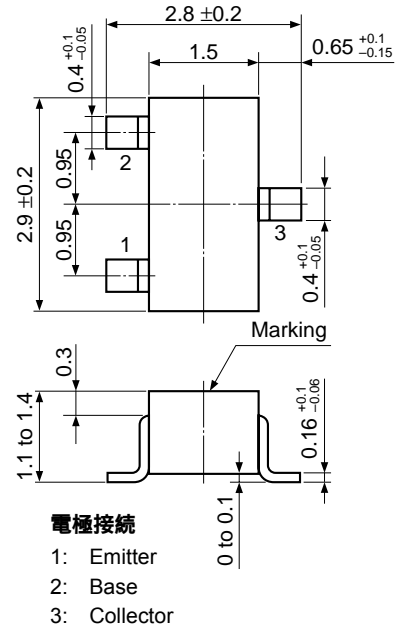
特 徴

超小形外形であり、ハイブリッドIC用として最適です。  
2SA812とコンプリメンタリで使用できます。  
 $h_{FE}$ が高い。 $h_{FE} = 200$  TYP. ( $V_{CE} = 6.0$  V,  $I_C = 1.0$  mA)  
耐圧が高い。 $V_{CEO} = 50$  V

絶対最大定格 ( $T_A = 25$  )

項 目	略 号	定 格	単 位
コレクタ・ベース間電圧	$V_{CBO}$	60	V
コレクタ・エミッタ間電圧	$V_{CEO}$	50	V
エミッタ・ベース間電圧	$V_{EBO}$	5.0	V
コレクタ電流 (直流)	$I_{C(DC)}$	100	mA
全損失	$P_T$	200	mW
ジャンクション温度	$T_j$	150	
保存温度	$T_{stg}$	- 55 ~ + 150	

★ 外形図 (単位 : mm)



電気的特性 ( $T_A = 25$  )

項 目	略 号	条 件	MIN.	TYP.	MAX.	単 位
コレクタしゃ断電流	$I_{CBO}$	$V_{CB} = 60$ V, $I_E = 0$ A			100	nA
エミッタしゃ断電流	$I_{EBO}$	$V_{EB} = 5.0$ V, $I_C = 0$ A			100	nA
直流電流増幅率	$h_{FE}$	$V_{CE} = 6.0$ V, $I_C = 1.0$ mA <sup>注</sup>	90	200	600	
直流ベース電圧	$V_{BE}$	$V_{CE} = 6.0$ V, $I_C = 1.0$ mA <sup>注</sup>	0.55	0.62	0.65	V
ベース飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C = 100$ mA, $I_B = 10$ mA <sup>注</sup>		0.86	1.0	V
コレクタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = 100$ mA, $I_B = 10$ mA <sup>注</sup>		0.15	0.3	V
利得帯域幅積	$f_T$	$V_{CE} = 6.0$ V, $I_E = - 10$ mA		250		MHz
コレクタ容量	$C_{ob}$	$V_{CB} = 6.0$ V, $I_E = 0$ , $f = 1.0$ MHz		3.0		pF

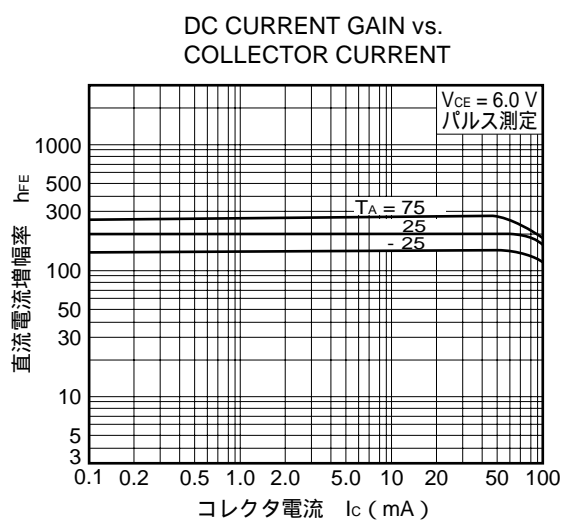
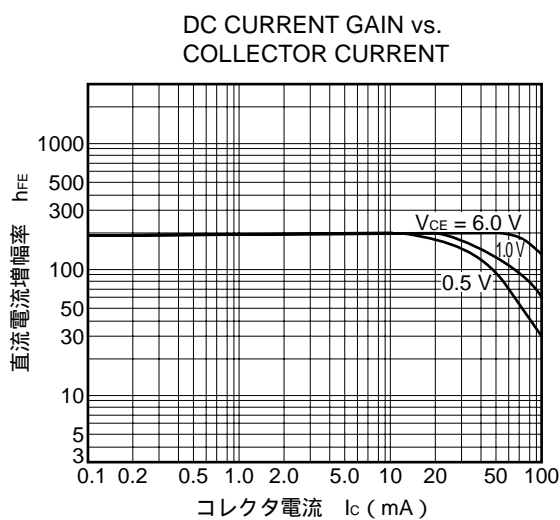
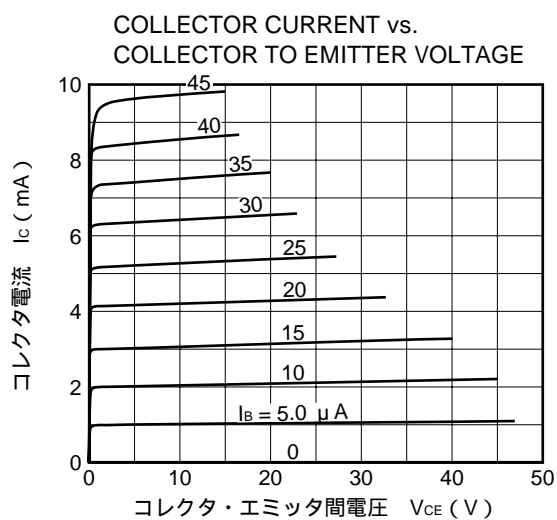
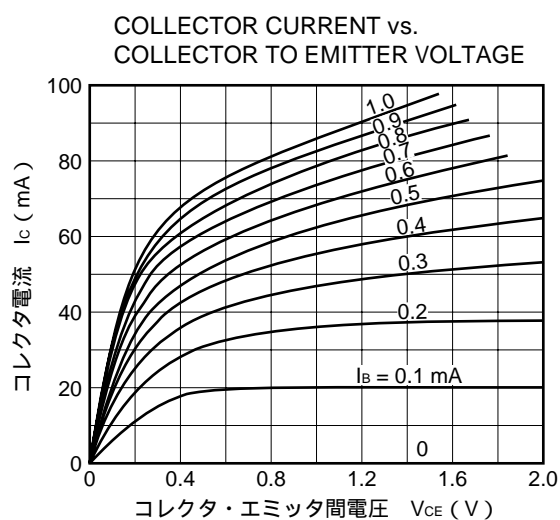
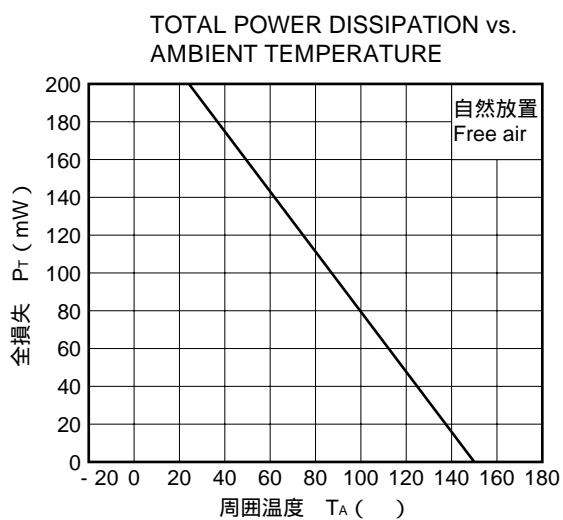
注 パルス測定 : PW 350  $\mu$ s, Duty Cycle 2%

$h_{FE}$ 規格区分

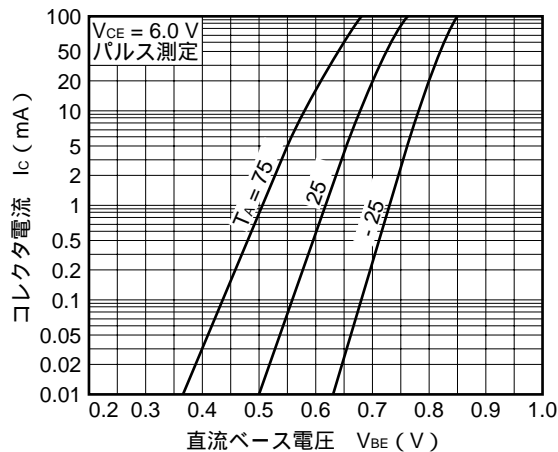
捺 印	L4	L5	L6	L7
$h_{FE}$	90 ~ 180	135 ~ 270	200 ~ 400	300 ~ 600

本資料の内容は、予告なく変更することがありますので、最新のものであることをご確認の上ご使用ください。

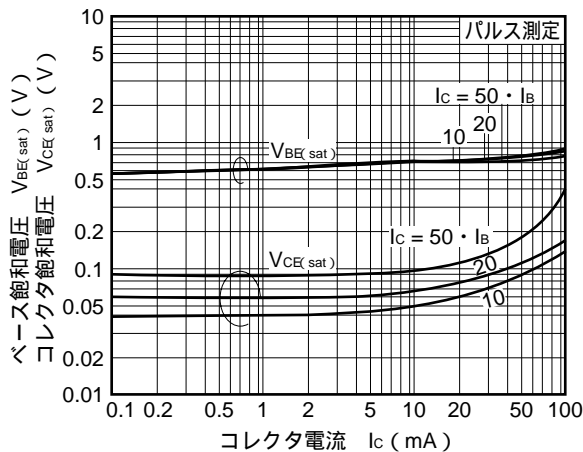
特性曲線 (TA = 25 )



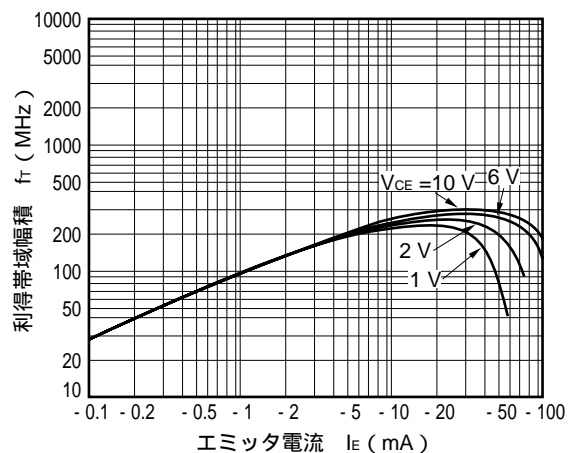
COLLECTOR CURRENT vs. BASE TO EMITTER VOLTAGE



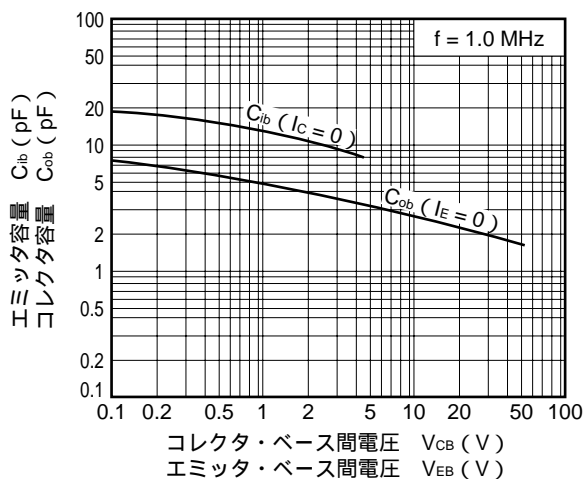
COLLECTOR AND BASE SATURATION VOLTAGE vs. COLLECTOR CURRENT



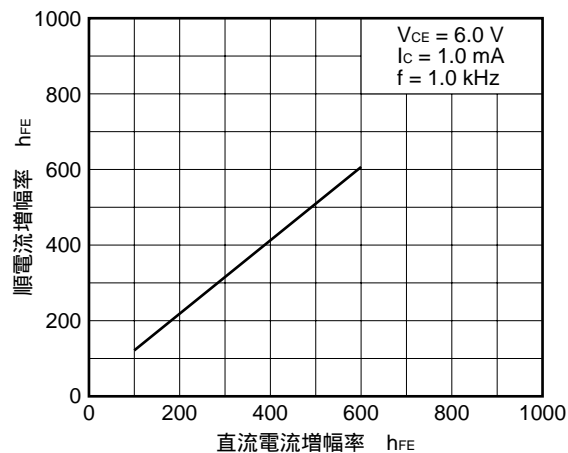
GAIN BANDWIDTH PRODUCT vs. EMITTER CURRENT



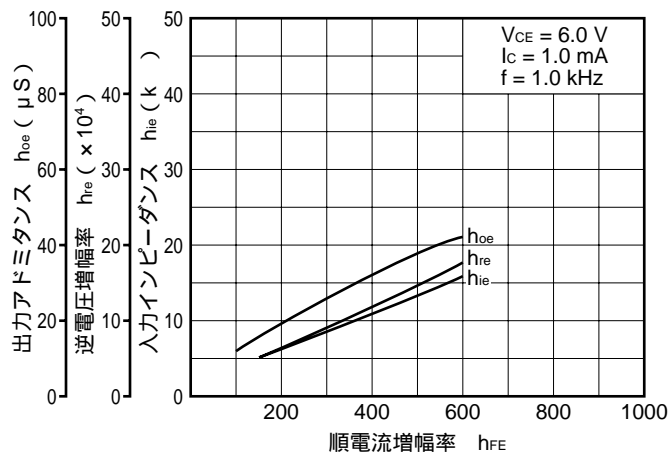
INPUT AND OUTPUT CAPACITANCE vs. REVERSE VOLTAGE



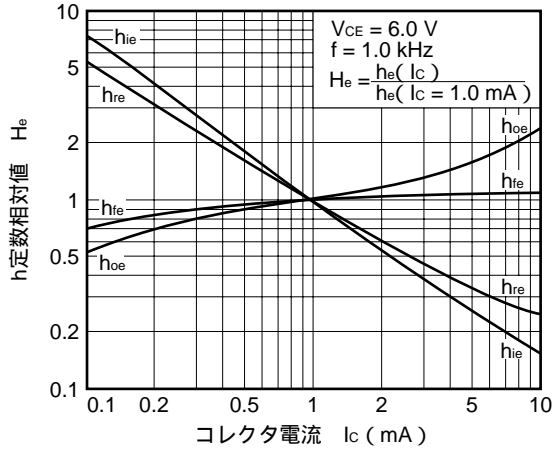
SMALL SIGNAL CURRENT GAIN vs. DC CURRENT GAIN



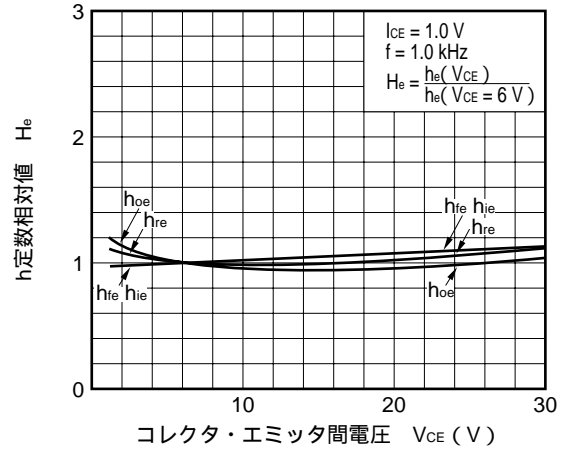
INPUT IMPEDANCE VOLTAGE FEEDBACK RATIO AND OUTPUT ADMITTANCE vs. SMALL SIGNAL CURRENT GAIN



NORMALIZED h-PARAMETER vs. COLLECTOR CURRENT



NORMALIZED h-PARAMETER vs. COLLECTOR TO EMITTER VOLTAGE



- 本資料に記載されている内容は2004年6月現在のもので、今後、予告なく変更することがあります。量産設計の際には最新の個別データ・シート等をご参照ください。
- 文書による当社の事前の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。当社は、本資料の誤りに関し、一切その責を負いません。
- 当社は、本資料に記載された当社製品の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、一切その責を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
- 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責を負いません。
- 当社は、当社製品の品質、信頼性の向上に努めておりますが、当社製品の不具合が完全に発生しないことを保証するものではありません。当社製品の不具合により生じた生命、身体および財産に対する損害の危険を最小限度にするために、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等安全設計を行ってください。
- 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「特別水準」およびお客様に品質保証プログラムを指定していただく「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。

標準水準：コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット

特別水準：輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器

特定水準：航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器、生命維持のための装置またはシステム等

当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。意図されていない用途で当社製品の使用をお客様が希望する場合には、事前に当社販売窓口までお問い合わせください。

(注)

- (1) 本事項において使用されている「当社」とは、NECエレクトロニクス株式会社およびNECエレクトロニクス株式会社とその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいう。
- (2) 本事項において使用されている「当社製品」とは、(1)において定義された当社の開発、製造製品をいう。

M8E 02.11

## 【発行】

### NECエレクトロニクス株式会社

〒211-8668 神奈川県川崎市中原区下沼部1753

電話（代表）：044(435)5111

お問い合わせ先

## 【ホームページ】

NECエレクトロニクスの情報がインターネットでご覧になれます。

URL(アドレス) <http://www.necel.co.jp/>

## 【営業関係、技術関係お問い合わせ先】

半導体ホットライン

(電話：午前 9:00～12:00、午後 1:00～5:00)

電話：044-435-9494

E-mail：info@necel.com

## 【資料請求先】

NECエレクトロニクスのホームページよりダウンロードいただくか、NECエレクトロニクスの販売特约店へお申し付けください。